

Invenția se referă la domeniul tehnicilor de măsurare și poate fi utilizată în dispozitivele de măsurare în care sunt utilizați senzori pe bază de oxizi semiconductori nanostructurați.

Este cunoscut un dispozitiv de măsurare a rezistenței senzorilor bazat pe legea lui Ohm pentru circuite electrice sau punți de măsurare, care include măsurarea rezistenței active pe curent continuu cu ajutorul ohmmetrului digital, galvanometrului diferențial și potențiometrului curentului continuu, precum și o metodă de măsurare a rezistenței senzorilor, care se bazează pe legea lui Ohm pentru circuite electrice, care include măsurarea rezistenței active la un curent continuu cu ajutorul unei punți electrice cu patru brațe și a unui voltmetru digital [1].

Cea mai apropiată soluție este un dispozitiv de măsurare a rezistenței senzorilor pe bază de oxizi semiconductori nanostructurați, care include o sursă de tensiune de referință conectată la un voltmetru și unită în serie cu senzorul nanostructurat cercetat și cu un rezistor suplimentar, la nodul de conectare a căruia cu senzorul este conectată intrarea unui amplificator; ieșirea amplificatorului este conectată la un voltmetru, totodată rezistorul, nodurile comune ale sursei de tensiune de referință, amplificatorului și voltmetrele sunt conectate la masă, precum și o metodă de măsurare a rezistenței senzorilor pe bază de oxizi semiconductori nanostructurați, care constă în aceea că se măsoară tensiunea U_1 a sursei de tensiune de referință, măsoară tensiunea U_3 pe rezistorul suplimentar, se calculează valoarea tensiunii care cade pe senzorul cercetat conform formulei $U_x = U_1 - U_3$, se calculează valoarea curentului care trece prin senzorul cercetat conform formulei $I_x = U_3 / R_3$, iar calcularea valorii rezistenței senzorului R_x se efectuează conform legii lui Ohm, utilizând valorile obținute U_x și I_x [2].

Un dezavantaj al acestor dispozitive și metode este că la măsurarea rezistenței unui senzor nanostructurat la proba cercetată sunt aplicate tensiuni și curenți nereglementați, care poate duce la o disipare mare de energie electrică pe nanostructură și, ca urmare, la înrăutățirea parametrilor sau deteriorarea nanostructurii.

Problema soluționată de invenție constă în elaborarea unui dispozitiv și a unei metode care în procesul de măsurare a rezistenței nanostructurii va monitoriza energia electrică disipată pe nanostructură și o va menține în valori prestabilite sigure.

Dispozitivul, conform invenției, înlătură dezavantajele de mai sus prin faptul că include o sursă de tensiune de referință reglabilă U_{ref} , conectată la ieșirea unui microcontroler și unită în serie cu senzorul nanostructurat cercetat R_x și un rezistor de referință R_o , punctul de legătură al căruia cu senzorul cercetat R_x este conectat la intrarea microcontrolerului, totodată circuitele comune al rezistorului de referință R_o , sursei de tensiune de referință U_{ref} și ale microcontrolerului sunt unite la pământ.

Metoda, conform invenției, elimină posibilitatea de depășire în timpul măsurării a puterii admisibile în nanostructură prin faptul că se măsoară tensiunea U_{ref} a sursei de tensiune de referință, se măsoară căderea de tensiune pe rezistorul de referință U_{ro} , se calculează căderea de tensiune pe nanostructura cercetată conform formulei $U_{R_x} = U_{ref} - U_{ro}$, se calculează valoarea curentului care trece prin nanostructură după formula $I_{R_x} = U_{R_x} / R_o$, se calculează puterea aplicată pe nanostructură $P_{R_x} = I_{R_x} * U_{R_x}$, se setează valoarea tensiunii de referință U_{ref} astfel, încât puterea P_{R_x} să nu depășească valoarea maxim admisibilă P_m în conformitate cu expresia $P_{R_x} \leq P_m$, se calculează valoarea rezistenței senzorului R_x conform legii lui Ohm, utilizând valorile obținute U_{R_x} și I_{R_x} .

Rezultatul invenției constă în eliminarea riscului de deteriorare a nanostructurii din cauza depășirii valorii maxim admisibile a puterii electrice aplicate la nanostructură.

Invenția se explică prin desenul din figură, în care este prezentată schema-bloc a dispozitivului de măsurare a rezistenței senzorilor pe baza metodei propuse. Schema-bloc a dispozitivului cuprinde: o sursă de tensiune de referință reglabilă U_{ref} , la intrarea căreia este aplicat un semnal de control de la schema de dirijare, care reprezintă un microcontroler, sursa de tensiune de referință reglabilă U_{ref} este unită în serie cu senzorul nanostructurat cercetat R_x și un rezistor de referință R_o , căderile de tensiune ale cărora sunt digitalizate prin intermediul convertoarelor analogic-digitale încorporate în microcontroler, de asemenea acesta procesează datele recepționate cu scopul de a calcula valoarea rezistenței nanostructurii cercetate, de a calcula valoarea și de a menține la o anumită mărime puterea electrică disipată în nanostructură prin controlul valorii U_{ref} . Punctele comune R_o ale schemei de control și sursei de tensiune de referință sunt unite la pământ.

Procesul de măsurare a rezistenței senzorilor pe bază de oxizi semiconductori nanostructurați este efectuat după cum urmează.

La prima etapă se măsoară tensiunea sursei de tensiune de referință U_{ref} .

La etapa a doua se măsoară căderea de tensiune pe rezistorul de referință U_{R_o} .

La a treia etapă se calculează căderea de tensiune pe nanostructura cercetată

$$U_{R_x} = U_{ref} - U_{R_o} \quad [1]$$

La a patra etapă se calculează curentul ce trece prin nanostructură

$$I_{R_x} = I_{R_o} = U_{R_x} / R_o \quad [2]$$

La etapa a cincea se calculează puterea electrică disipată pe nanostructură

$$P_{R_x} = I_{R_x} * U_{R_x} = U_{R_o} * (U_{ref} - U_{R_o}) / R_o \quad [3]$$

La etapa a șasea este stabilită o tensiune a sursei de referință cu așa o valoare, încât puterea disipată în nanostructură să nu o depășească pe cea maxim admisibilă P_m

$$P_{R_x} \leq P_m \quad [4]$$

La a șaptea etapă, după determinarea repetată a U_{R_0} și U_{ref} , se calculează valoarea rezistenței nanostructurii

$$R_x = U_{R_x} / I_{R_x} = (U_{ref} - U_{R_0}) * R_0 / U_{R_0} \quad [5]$$

Drept exemplu de aplicare practică a metodei descrise sunt prezentate rezultatele măsurătorilor următorilor parametri: rezistența rezistorului de referință $R_0=10$ kOhm; tensiunea sursei de tensiune de referință $U_{ref}=20$ V; tensiunea pe rezistorul de referință $U_{R_0}=0,2$ V; puterea maxim admisibilă pe structura studiată $P_m=0,5$ mW; puterea reală disipată pe nanostructură $P_{R_x}=U_{R_0}/R_0*(U_{ref}-U_{R_0})=0,2/10000*(20-0,2)=0,4$ mW<0,5mW, rezistența nanostructurii $R_x=(U_{ref}-U_{R_0})*R_0/U_{R_0}=(20-0,2)*10000/0,2=990$ kOhm.